



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1300

对应国外型号
2SA1300

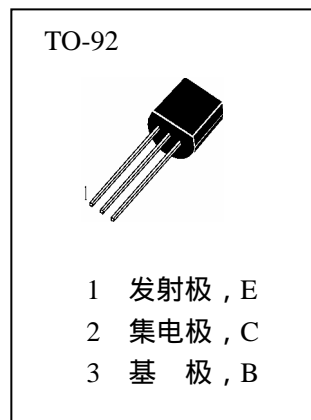
主要用途

音频放大/电流驱动。

外形图及引脚排列

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	750mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-20V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-10V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-6V
I_C ——集电极电流.....	-2A
I_{CP} ——集电极电流(脉冲宽度 10ms , 占空比 30%).....	-5A



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-20			V	$I_C=-100\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-10			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-6			V	$I_E=-1mA, I_C=0$
$HFE(1)$	直流电流增益	140		600		$V_{CE}=-1V, I_C=-500mA$
$HFE(2)$		70				$V_{CE}=-1V, I_C=-2A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	$I_C=-2A, I_B=-50mA$
V_{BE}	基极—发射极电压			-1.5	V	$V_{CE}=-1V, I_C=-2A$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{CB}=-20V, I_E=0$
I_{CEO}	集电极—发射极截止电流			100	nA	$V_{CE}=-10V, I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{EB}=-6V, I_C=0$
f_T	特征频率		140		MHZ	$V_{CE}=-1V, I_C=-500mA$
C_{ob}	共基极输出电容		50		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

HFE(1)分档及其标志

Y	GR	BL
140—280	200—400	300—600



特性曲线

